

● 硅 NPN 外延平面管

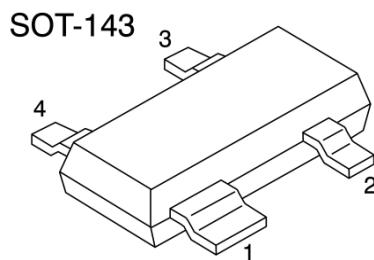
● 用途:

高频放大/振荡/混频

● 特点:

高传输频率 f_T ;

低输出电容 C_{ob} 、 C_{rb} ;



Part	BFG520/X
Pin	1C .2E .3B .4E
Marking	W M L

● 极限参数($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	单位	规范值
耗散功率	P_{tot}	mW	300
集电极电流	I_c	mA	70
结温	$T(j)$	$^\circ\text{C}$	125
存贮温度	T_{stg}	$^\circ\text{C}$	-55~+125
集电极-基极电压	V_{CBO}	V	20
集电极-发射极电压	V_{CEO}	V	10
发射极-基极电压	V_{EBO}	V	3

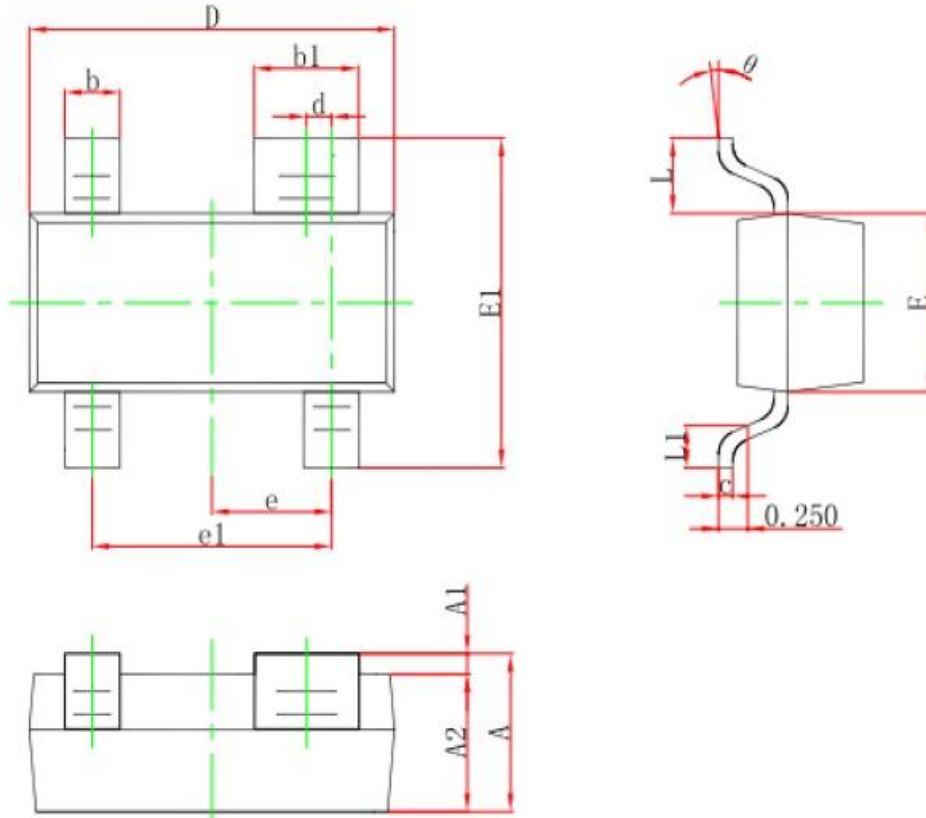
● 电参数($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	测试条件	最小值	最大值	单位
I_{CBO}	$V_{CB}=10\text{V}$ $I_{MAX}=10\ \mu\text{A}$		1.0	mA
I_{CEO}	$V_{CE}=8.0\text{V}$ $I_{MAX}=1\ \mu\text{A}$		5.0	μA
I_{EBO}	$V_{EB}=2.0\text{V}$ $I_{MAX}=500\ \mu\text{A}$		100	μA
H_{FE}	$V_{CE}=10\text{V}$ $I_C=20\text{mA}$	80	340	
f_T	$V_{CE}=10\text{V}$ $I_C=20\text{mA}$	TYP: 8.5		GHz
C_{ob}	$V_{CB}=5\text{V}$ $f=1\text{MHz}$	TYP: 1.0		pF
$ S_{21} ^2$	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_C=10\text{mA}$ $f=1.0\text{GHz}$	TYP: 13.9		dB
NF	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_C=5\text{mA}$ $f=1.0\text{GHz}$	TYP: 1.4		dB

● H_{FE} 分档

Rank	A	B	C	D
H_{FE}	80-100	100~180	180~260	260~340

● DIMENSION SOT-143 外形封装尺寸



Dimensions In Millimeters

Unit	A	A1	A2	b	b1	c	D	d	E	E1	e	e1	L	L1	θ
Max	1.30	0.10	1.20	0.50	0.95	0.15	3.00	0.20	1.40	2.55	0.95	2.00	0.55	0.50	8
Min	0.95	0.00	0.90	0.30	0.75	0.08	2.80	TYPE	1.20	2.25	TYPE	1.80	TYPE	0.30	0